

ウェハ表面温度モニタ kSA BandiT



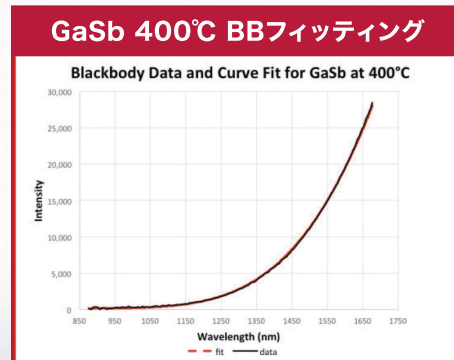
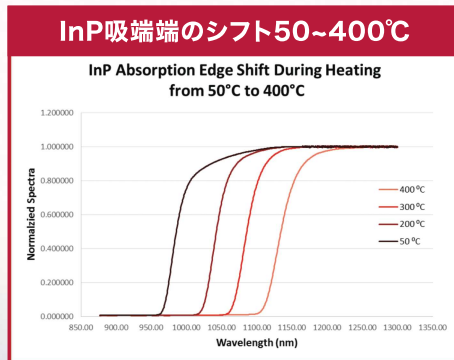
基板に照射した光の散乱光からバンドエッジ(吸収端)波長を検出、室温から高温まで正確に優れた再現性で基板温度を測定可能。

特徴

- ビューポートの堆積膜の影響を受けずに測定
- 放射温度計で必要な放射率の校正が不要
- 迷光や基板ヒーターなどからの光の影響を受けずに測定
- 測定対象の材質ごとに分光計のモデルが分かれている

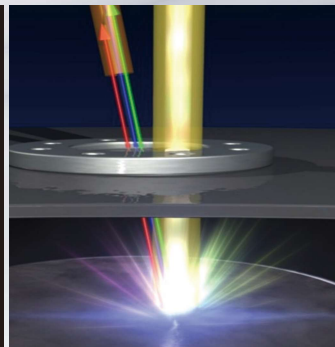


【 NIRモデル 】 GaAs, InP, Si / 【 VISモデル 】 GaN, SiC, ZnO, STO, 他 / 【 UVモデル 】 AlN, Ga₂O₃, ダイヤモンド, 他

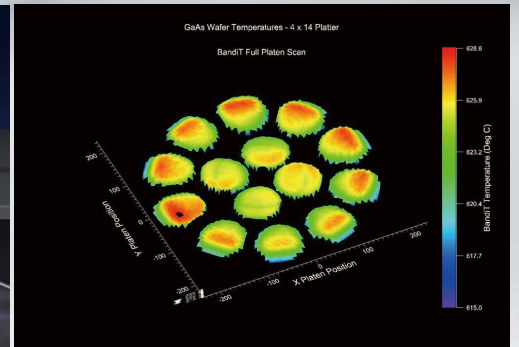


用途

MBE装置、MOCVD / MOVPE装置、スパッタ装置、エッチング装置などでの半導体ウェハ表面温度 in-situ 測定



基板への照射光と基板からの散乱光



プラテン上GaAs基板の温度マッピング測定例